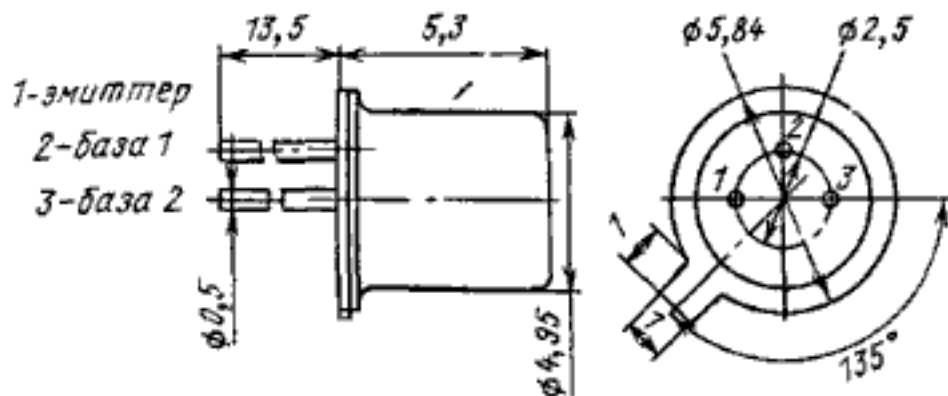


2Т117А, 2Т117Б, 2Т117В, 2Т117Г, КТ117А, КТ117Б, КТ117В, КТ117Г

Транзисторы кремниевые планарные однопереходные с *n*-ба-
зой

Предназначены для работы в маломощных генераторах
Выпускаются в металlostеклянном корпусе с гибкими выво-
дами. Обозначение типа приводится на корпусе
Масса транзистора не более 0,45 г



Электрические параметры

Коэффициент передачи напряжения при $U_{Б1Б2} = 10$ В	
при $T = 298$ К	
2Т117А, 2Т117В, КТ117А, КТ117В	0,5—0,7
2Т117Б, 2Т117Г	0,65—0,85
КТ117Б, КТ117Г	0,65—0,90
при $T = 343$ К	
2Т117А, 2Т117В, КТ117А, КТ117В	0,45—0,7
2Т117Б	0,6—0,85
2Т117Г	0,6—0,8
КТ117Б, КТ117Г	0,6—0,9
при $T = 213$ К	
2Т117А, 2Т117В, КТ117А, КТ117В	0,5—0,8
2Т117Б, 2Т117Г	0,65—0,9
КТ117Б, КТ117Г	0,65—0,95
Ток включения эмиттера при $U_{Б1Б2} = 10$ В не бо- лее	20 мкА
Ток выключения эмиттера при $U_{Б1Б2} = 20$ В не ме- нее	1 мА
Остаточное напряжение эмиттер-база не более	
при $T = 213 - 298$ К	5 В
при $T = 343$ К, $I_Э = 10$ мА 2Т117А, 2Т117Б, 2Т117В, 2Т117Г	4 В
при $T = 343$ К, $I_Э = 50$ мА КТ117А, КТ117Б, КТ117В, КТ117Г	4 В

Межбазовое сопротивление:при $T = 298 \text{ К}$:

2Т117А, 2Т117Б	4–7,5 кОм
2Т117В, 2Т117Г	6–9 кОм
КТ117А, КТ117Б	4–9 кОм
КТ117В, КТ117Г	8–12 кОм

при $T = 343 \text{ К}$:

2Т117В, 2Т117Г	6–15 кОм
КТ117В, КТ117Г	6–18 кОм

при $T = 213 \text{ К}$:

2Т117В, 2Т117Г	3–8,5 кОм
КТ117В, КТ117Г	4–12 кОм

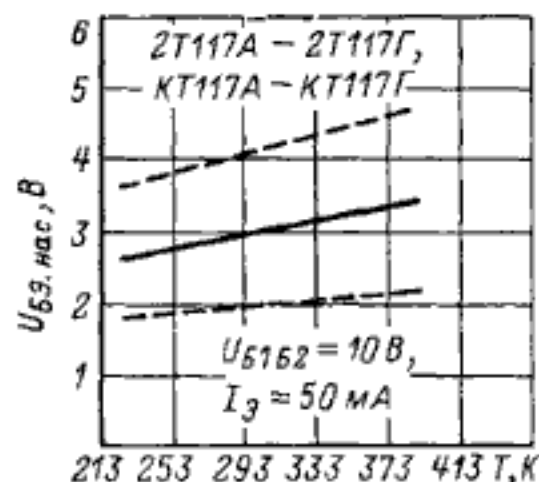
Температурный коэффициент межбазового сопротивле-

ния 0,1–0,9 %/К

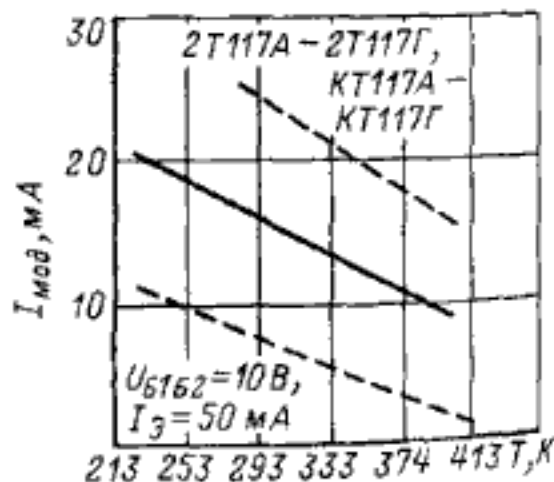
Наибольшая частота генерации 200 кГц**Обратный ток эмиттера при $U_{Б1Б2} = 30 \text{ В}$ не более:**при $T = 298 \text{ К}$ 1 мкАпри $T = 398 \text{ К}$ 10 мкА**Ток модуляции не менее 10 мА**

Предельные эксплуатационные данные

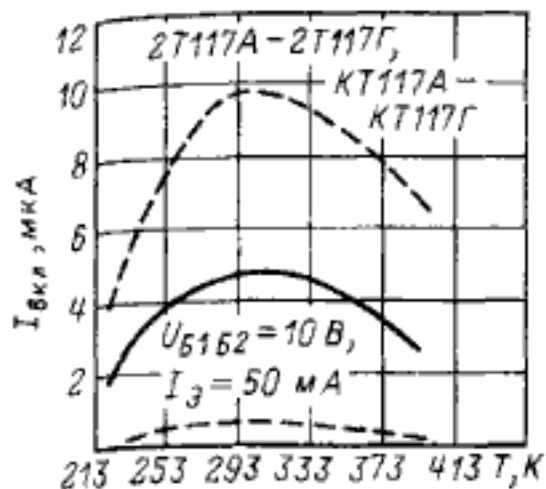
Постоянное межбазовое напряжение	30 В
Постоянное напряжение база 2-эмиттер	30 В
Постоянный ток эмиттера	50 мА
Импульсный ток эмиттера при $t_n \leq 10$ мкс, $Q \geq 200$. . .	1 А
Постоянная рассеиваемая мощность эмиттера:	
при $T = 213 \div 308$ К	300 мВт
при $T = 398$ К	15 мВт
Температура перехода	403 К
Температура окружающей среды	От 213 до 398 К



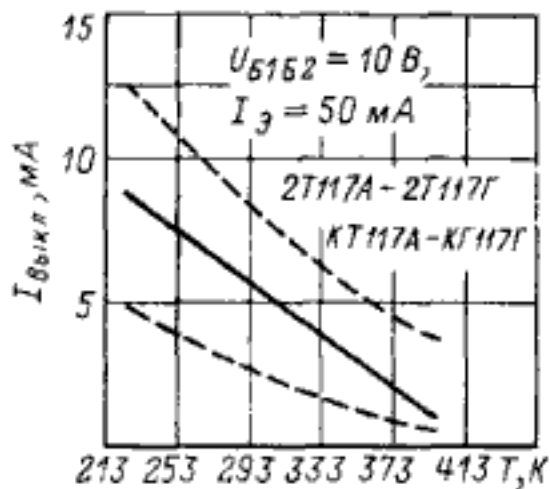
Зона возможных положений зависимости напряжения насыщения база-эмиттер от температуры.



Зона возможных положений зависимости тока модуляции от температуры.



Зона возможных положений зависимости тока включения от температуры.



Зона возможных положений зависимости тока выключения от температуры.